

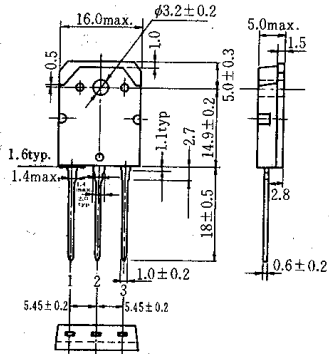
# 2SJ113

シリコン P チャネル MOS FET

高速度電力スイッチング用  
2SK399 とコンプリメンタリペア

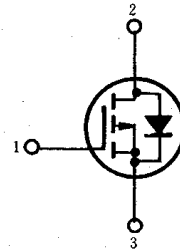
SILICON P-CHANNEL MOS FET

HIGH SPEED POWER SWITCHING  
Complementary pair with 2SK399



(TO-3P)

1. ゲート : Gate
2. ドレイン : Drain  
(フランジ) (Flange)
3. ソース : Source  
(Dimensions in mm)



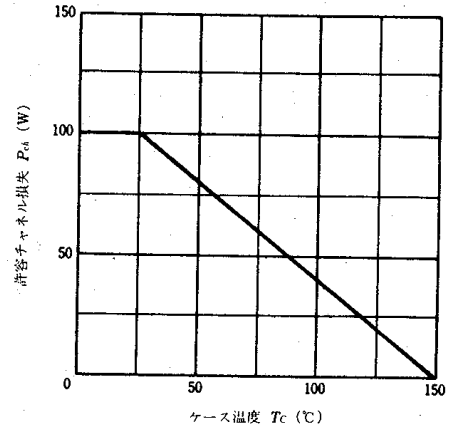
## ■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項	目	Symbol	2SJ113	Unit
ドレイン・ソース電圧	$V_{DSS}$		-100	V
ゲート・ソース電圧	$V_{GSS}$		$\pm 20$	V
ドレイン電流	$I_D$		-10	A
せん頭ドレイン電流	$I_{D(peak)}$		-15	A
逆ドレイン電流	$I_{DR}$		-10	A
許容チャネル損失	$P_{cA}^*$		100	W
チャネル温度	$T_{cA}$		150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$		-55~+150	$^\circ\text{C}$

\*  $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値

\* Value at  $T_c=25^\circ\text{C}$

## 許容チャネル損失のケース温度による変化 MAXIMUM CHANNEL DISSIPATION CURVE



## ■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項	目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
ドレイン・ソース破壊電圧	$V_{(BR)DSS}$		$I_D=-10\text{mA}$ , $V_{GS}=0$	-100	—	—	V
ゲート遮断電流	$I_{GSS}$		$V_{GS}=\pm 20\text{V}$ , $V_{DS}=0$	—	—	$\pm 1$	$\mu\text{A}$
ドレイン電流	$I_{DSS}$		$V_{DS}=-80\text{V}$ , $V_{GS}=0$	—	—	-1	mA
ゲート・ソース遮断電圧	$V_{GS(off)}$		$I_D=-1\text{mA}$ , $V_{DS}=-10\text{V}$	-2.0	—	-5.0	V
ドレイン・ソースオン抵抗	$R_{DS(on)}$		$I_D=-5\text{A}$ , $V_{GS}=-15\text{V}^*$	—	0.25	0.35	$\Omega$
ドレイン・ソース飽和電圧	$V_{DS(on)}$		$I_D=-5\text{A}$ , $V_{GS}=-15\text{V}^*$	—	-1.25	-1.75	V
順伝達アドミタンス	$ y_{fs} $		$I_D=-5\text{A}$ , $V_{DS}=-10\text{V}^*$	1.5	2.0	—	S
入力容量	$C_{iss}$		$V_{DS}=-10\text{V}$ , $V_{GS}=0$ $f=1\text{MHz}$	—	1100	—	pF
出力容量	$C_{oss}$			—	650	—	pF
逆伝達容量	$C_{rss}$			—	90	—	pF
ターンオン遅延時間	$t_{d(on)}$		$I_D=-2\text{A}$ , $V_{GS}=-15\text{V}$ , $R_L=15\Omega$	—	20	—	ns
立ち上がり時間	$t_r$			—	50	—	ns
ターンオフ遅延時間	$t_{d(off)}$			—	90	—	ns
下降時間	$t_f$			—	70	—	ns
ダイオード順電圧	$V_{DF}$		$I_F=-5\text{A}$ , $V_{GS}=0$	—	-0.9	—	V
逆回復時間	$t_{rr}$		$I_F=-5\text{A}$ , $V_{GS}=0$ $di_F/dt=50\text{A}/\mu\text{s}$	—	250	—	ns

\* パルス測定

\* Pulse Test